

型号：SLS2N60

N-CHANNEL MOSFET in a TO-252 Plastic Package.

主要特性/Features

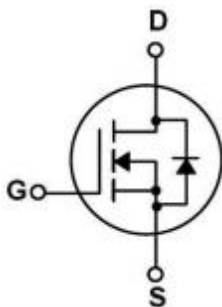
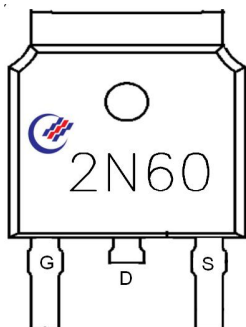
低栅电荷, 低反馈电容, 开关速度快。
Low gate charge, low crss, fast switching.

应用/Application

用于高功率DC/DC转换和功率开关。

These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

印字/MARKING等效电路/Equivalent Circuit



极限参数/Absolute Maximum Ratings (TA=25°C unless otherwise noted)

参数名称	符号	额定值	单位
最高漏源电压	V_{DSX}	600	V
连续漏极电流 $T_C=25^\circ\text{C}$	I_D	2	A
连续漏极电流 $T_C=100^\circ\text{C}$	I_D	1.4	A
脉冲漏极电流	I_{DM}^{al}	8	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
耗散功率 ($T_a=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	35	W
结温	T_j	150	$^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量	E_{as}	80	mJ

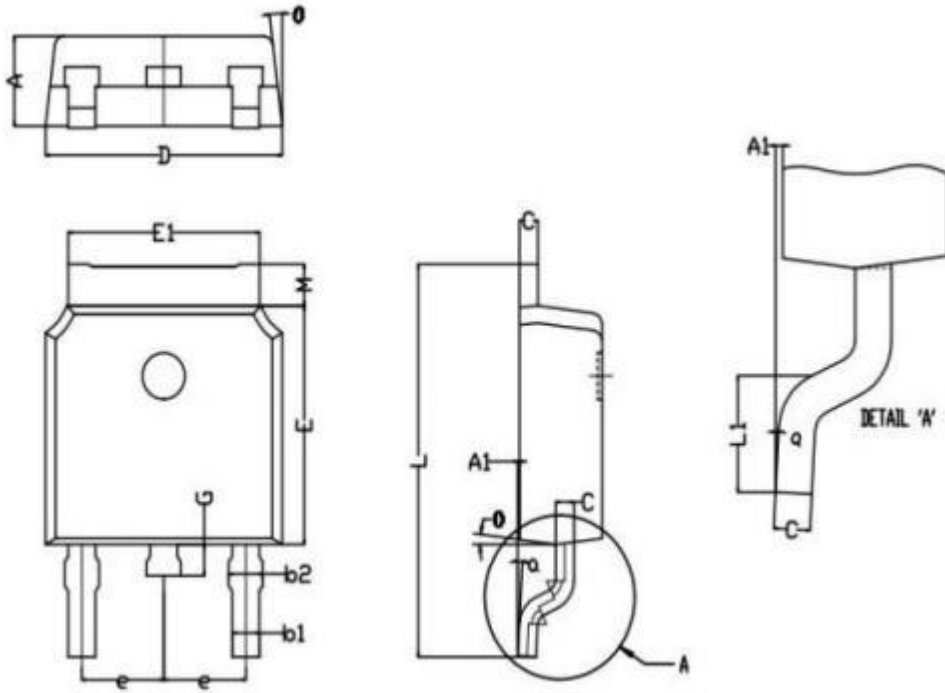
T0252-2L Plastic-Encapsulate

电性能参数/Electrical Characteristics (TA=25°C unless otherwise noted)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
漏源反向电压	V_{DS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600			V
通态电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=1A$			4.5	Ω
阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2		4	V
源漏正向压降	V_{SD}	$V_{GS}=0V, I_{DS}=2A$			1.5	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V, T_c=25^\circ C$			1	μA
		$V_{DS}=480V, V_{GS}=0V, T_c=125^\circ C$			100	μA
源栅漏电流	$I_{GSS(F)}$	$V_{GS}=+30V$			100	nA
源栅漏电流	$I_{GSS(R)}$	$V_{GS}=-30V$			-100	nA
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$ $f=1.0MHz$		280		pF
输出电容	C_{oss}			30		pF
反向传输电容	C_{rss}			4.5		pF
a: 脉冲测试 $t_p \leq 300 \mu s, \delta \leq 2\%$						



成品外观尺寸/T0252-2LPackageInformation



Symbol	Dim in mm		
	Min	Nor	Max
A	2.25	2.30	2.35
L1	2.90	3.00	3.10
b1	0.71	0.76	0.81
b2	0.91	0.96	1.01
C	0.46	0.51	0.56
D	6.55	6.60	6.65
e	2.29 (BSC)		
E	6.05	6.10	6.15
E1	5.23	5.33	5.43
L	9.84	10.04	10.24
A1	0.00	0.05	0.10
M	1.01	1.06	1.11
G	0.70	0.80	0.90
Q	0°	5°	10°
Q	0°	3°	6°